


Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 PC) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GWG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	1	Leersteckeinheit	2364-506-1	
2				
3				
4				
5	38	Transistor Halter	2587-676-1	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12		Schlüssel Einbau	2587-680-1	
13				
14				
15	30	Isolierschlauch	2699-329-32	für Transistor
16	30	Isolierschlauch	2699-329-132	für Transistor
17	30	Isolierschlauch	2699-329-232	für Transistor
18				
19				
20		Stromlaufplan	3361-463 -1	
21		Bauschaltplan Bl.1	3461-463 -1	
22		Legeliste Bl.1	3861-463 -1	
23				
24				
25				
26		Darstellung v. Bauelementen m. axialen Anschlüssen	24-5429-.....	
27			24-5430-..	
28		Abbiegung v. Bauelementen in Senkrechtbauweise	24-5459-.....	
29				
30				
31				
32				
33	320	Lötstift	2635-592-1	Einbau nach 24-5436-1
34				
35		Beschriftung	SA 8-08	
36				

73 542

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 8 -08 Steuerung Akkumulator	
Gez.					
		Blatt 3861 - 463 - 1		1...5	
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.


V 6421 04-79

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
D1	1	Germaniumdiode	L8011	WN 5457	07202
D2	1	"	L8011	WN 5457	05202
D3	1	"	L8011	WN 5457	05202
D4	1	"	L8011	WN 5457	05202
D5	1	"	L8011	WN 5457	05202
D6	1	"	L8011	WN 5457	07202
D7	1	"	L8011	WN 5457	05202
D8	1	"	L8011	WN 5457	07202
D9	1	"	L8011	WN 5457	05202
D10	1	"	L8011	WN 5457	07202
D11	1	"	L8011	WN 5457	05261
D12	1	"	L8011	WN 5457	05261
D13	1	"	L8011	WN 5457	05261
D14	1	"	L8011	WN 5457	05261
D15	1	"	L8011	WN 5457	05261
D16	1	"	L8011	WN 5457	05261
D17	1	"	L8011	WN 5457	05261
D18	1	"	L8011	WN 5457	05261
D19	1	"	L8011	WN 5457	05261
D20	1	"	L8011	WN 5457	05261
D21	1	"	L8011	WN 5457	05261
T1	1	Hf-Schalttransistor	A30	WN 5444	
T2	1	"	A30	WN 5444	
T3	1	"	A30	WN 5444	

73 542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 8-08 Steuerung Akkumulator	
Bez.					
a 21.11.59 NIF 767 Müller Jr.				3E61 - 463 - 1	
Ausg	Tag			Mitteilung	Bearbeiter

Blatt
2...
...

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mittheilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
T4	1	Hf-Schalttransistor	A30	WN 5444	
T5	1	"	A30	WN 5444	
T6	1	"	A30	WN 5444	
T7	1	"	A30	WN 5444	
T8	1	"	A30	WN 5444	
T9	1	"	A30	WN 5444	
T10	1	"	A30	WN 5444	
T11	1	"	A30	WN 5444	
T12	1	"	A30	WN 5444	
T13	1	"	A30	WN 5444	
T14	1	"	A30	WN 5444	
T15	1	"	A30	WN 5444	
T16	1	"	A30	WN 5444	
T17	1	"	A30	WN 5444	
T18	1	"	A30	WN 5444	
T19	1	"	A30	WN 5444	
T20	1	"	A30	WN 5444	
T21	1	"	A30	WN 5444	
T22	1	"	A30	WN 5444	
T23	1	"	A30	WN 5444	
T24	1	"	A30	WN 5444	
T25	1	"	A30	WN 5444	
T26	1	"	A30	WN 5444	
T27	1	"	A30	WN 5444	
T28	1	"	A30	WN 5444	
T29	1	"	A30	WN 5444	
T30	1	"	A30	WN 5444	

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 8-08 Steuerung Akkumulator	
Gez.					
a 21.11.59 NIF 767		Müller Jr.		Blatt 3E61 - 463 - 1 3...	
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter		

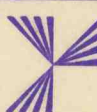


»Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.«

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.	Bemerkungen
R1	1	Schichtwiderstand	10k/2/2 WN 5121	05260
R2	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R3	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R4	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R5	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R6	1	"	5k/2/2 WN 5121	05260
R7	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R8	1	"	5k/2/2 WN 5121	05260
R9	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R10	1	"	16k/2/2 WN 5121	05260
R11	1	"	4k/2/2 WN 5121	07200
R12	1	"	2k/2/2 WN 5121	1722
R13	1	"	4k/2/2 WN 5121	07200
R14	1	"	2k/2/2 WN 5121	1722
R15	1	"	4k/2/2 WN 5121	07200
R16	1	"	2k/2/2 WN 5121	1722
R17	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R18	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R19	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R20	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 8-08 Steuerung Akkumulator	
Gez.					
 STANDARD ELEKTRIK LORENZ		3E61 - 463 - 1		Blatt	
				...4	
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.
a	21.11.59	NIF 767	Müller	Jr.	

